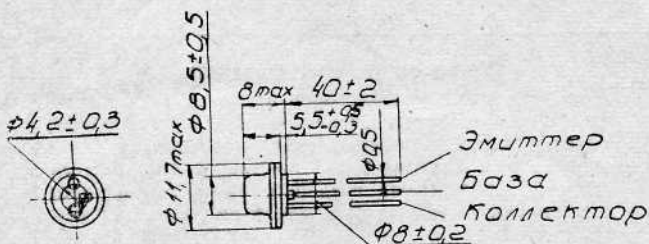




## Паспорт

Транзистор германиевый плоскостной р-п-р типа 1610Б ОС  
СБО.336.003 СЧТУ



Электрические параметры при температуре  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$   
(в схеме с общей базой)

Коэффициент усиления по току (при напряжении коллектора минус 5 в, токе эмиттера 1 ма и частоте 1 кГц)	40-80
Выходная проводимость (при напряжении коллектора минус 5 в, токе эмиттера 1 ма и частоте 1 кГц)	не более 2,5 мкмо
Обратный ток коллектора (при напряжении коллектора минус 20 в и сопротивлении база-эмиттер равном нулю)	не более 30 мка
Обратный ток эмиттера (при напряжении эмиттера минус 20 в)	не более 30 мка
Предельная частота усиления по току (при напряжении коллектора минус 5 в и токе эмиттера 1 ма)	не менее 1 МГц
Сопротивление базы на высокой частоте (при напряжении коллектора минус 5 в, токе эмиттера 1 ма и частоте 500 кГц)	не более 150 ом
Емкость коллектора (при напряжении коллектора минус 5 в, токе эмиттера 1 ма и частоте 500 кГц)	не более 50 пф

### Предельно-допустимые эксплуатационные данные

Напряжение коллектор-база, коллектор-эмиттер, эмиттер-база во всем диапазоне рабочих температур . . . . . минус 20 в

Примечание: для напряжения коллектор-эмиттер при отсутствии запирающего смещения, сопротивление в цепи база-эмиттер не должно превышать 2 ком.

Ток коллектора в режиме усиления . . . . . 20 ма

Ток коллектора в режиме переключения или в импульсном режиме . . . . . 150 ма

Среднее значение тока эмиттера . . . . . 20 ма

Мощность, рассеиваемая транзистором при температуре окружающей среды до плюс 55°C . . . . . 150 мвт

Примечание: при повышении температуры окружающей среды мощность, рассеиваемая транзистором, снижается по линейному закону.

Мощность, рассеиваемая транзистором при температуре плюс 70°C . . . . . 75 мвт

Диапазон рабочих температур от минус 60°C до плюс 70°C.

## Указания по эксплуатации

1. При включении транзисторов в схемы, находящиеся под напряжением, базовый вывод должен присоединяться первым и отключаться последним.
2. Транзисторы должны быть жестко закреплены за корпус. При монтаже транзисторов рекомендуется выводы закреплять на расстоянии не более 15 мм от корпуса.
3. Разрешается производить пайку выводов на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора. При пайке паяльником должен быть обеспечен надежный теплоотвод между местом пайки и корпусом транзистора. Пайку рекомендуется производить паяльником мощностью не более 30 Вт в течение времени не более 5 секунд. Пайку погружением следует производить в течение времени не более 5 сек. окунанием в расплавленный припой с температурой не выше  $285^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ .
4. Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора.
5. Рекомендуется эксплуатировать транзисторы в диапазоне температур от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$  (для германиевых) и от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+100^{\circ}\text{C}$  (для кремниевых) при мощности рассеивания не более 0,7 Р max; напряжении коллектора не более 0,7  $U_{к\text{ max}}$  и не менее 0,3  $U_{к\text{ изм}}$ , при токе коллектора не более 0,9  $I_{к\text{ max}}$ , где:

Р max — предельно-допустимая мощность при максимально возможной в аппаратуре температуре;

$U_{к\text{ max}}$ ,  $I_{к\text{ max}}$  — предельно-допустимые значения напряжения и тока при данной температуре окружающей среды;

$U_{к\text{ изм}}$  — напряжение, при котором измеряется коэффициент усиления по току.

В случае выхода транзисторов из строя заполните следующие данные и отошлите поставщику:

Дата получения . . . . .	196	г.
Дата установки . . . . .	196	г.
Дата снятия с эксплуатации . . . . .	196	г.
Количество отработанных часов . . . . .		
Краткая характеристика схемы использования . . . . .		
Причины снятия с эксплуатации . . . . .		
Наименование и адрес потребителя . . . . .		
Дата заполнения « . . . . » . . . . .	196	г.
Подпись заполнявшего . . . . .		